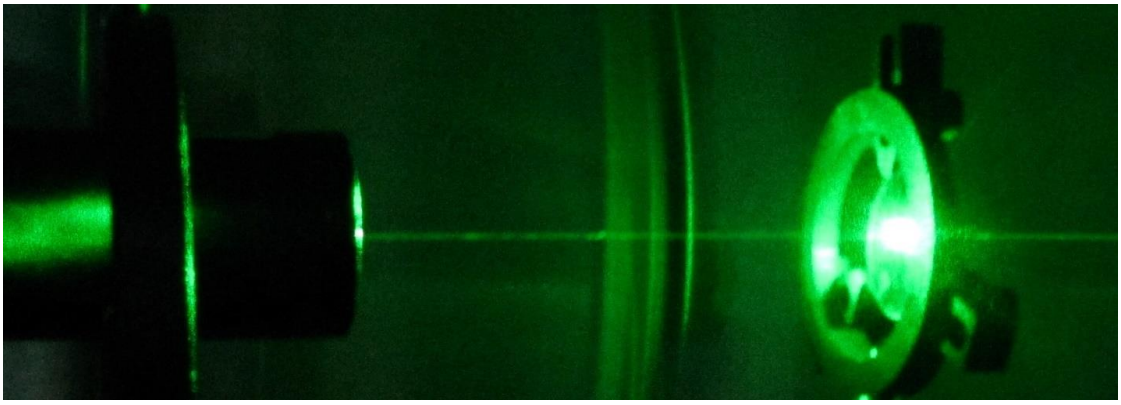
سامانه روبش-z



سامانه روبش–z برای اندازه‌گیری اثر خیر خطی کر استفاده می‌شود. فرایند اندازه‌گیری به شکل روبش نمونه در نقطه کانون لیزر می‌باشد. طی روبش نمونه، دو پدیده خود کانونی در اثر ضریب شکست غیر خطی و جذب دو فوتونی رخ می‌دهد.

دستگاه حاضر از لیزر دیودی ۵۳۲ نانومتری به عنوان منبع نوری و از جابجاگری با دقت ۵۰ میکرون به عنوان ابزار روبش در کانون لیزر استفاده می‌کند. از مزیت‌های این دستگاه کنترل کامپیوتری آن است. توسط این دستگاه می‌توان ضرایب جذب و شکست غیر خطی را محاسبه نمود به طوری که پس از اندازه‌گیری و پردازش داده‌های مربوط به حالت‌های دریچه باز و دریچه بسته، داده‌های پردازش شده و مقادیر ضرایب جذب و شکست غیر خطی بدست می‌آیند.